

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դ.Լ. Հովհաննիսյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Գ.Դ. Հովհաննիսյան, Կ.Ա. Հովհաննիսյան. Ֆեմտովայրկյանային օպտիկական սոլիտոնի միամոդ մանրաթելում տարածման թվային մոդելավորումը, միջավայրի ռամանյան արձագանքի կեղծ մասի հաշվառման դեպքում	391
Ա. Հակիմիֆարդ, Մ.Գ. Բարսեղյան, Կ.Ա. Դյուբե, Ա.Ա. Կիրակոսյան. Էլեկտրական դաշտի, հիդրոստատիկ ճնշման եվ ջերմաստիճանի ազդեցությունները էլեկտրոնային վիճակների վրա Պյոշլ-Թելերի քվանտային փոստում	401
Ռ.Կ. Հովսեփյան, Ն.Ռ. Աղամալյան, Ս.Ի. Պետրոսյան. ZnO:Li թաղանթից դաշտային տրանզիստոր	407
Ա.Վ. Ղազարյան, Ա.Խ. Մանասեյան, Ա.Ա. Կիրակոսյան. Էլեկտրոնային վիճակները ZnSe գլանային քվանտային կետի վալենտական գոտում	417
Վ.Կ. Աբրահամյան, Ն.Հ. Հակոբյան, Վ.Մ. Հարությունյան, Հ.Լ. Մարգարյան, Դ.Լ. Հովհաննիսյան. Հեղուկ բյուրեղային փուլային մոդուլյատորի միացման ժամանակի բարելավումը լրացուցիչ կառավարող լարման միջոցով	429
Ս.Վ. Մելքոնյան, Ա.Վ. Սուրմալյան. Էլեկտրոնների շարժունակության դիսպերսիայի առանձնահատկությունները հոմոէդերեո կիսահաղորդիչներում	440
Մ.Ս. Ալեքսանյան, Վ.Մ. Առաքելյան, Վ.Մ. Հարությունյան, Ա.Զ. Աղամյան, Գ.Է. Շահնազարյան. Գազային սենսոր նանոչափային $\text{In}_2\text{O}_3:\text{Ga}_2\text{O}_3$ թաղանթի հիման վրա	447
Շ.Ա. Տոնոյան. Երկմասշտաբային պոլիպեպտիդային շղթայի ընդհանրացված մոդելը համակցված լուծիչում	456
Ս.Ի. Բոժեվոլնի, Խ.Վ. Ներկարարյան, Ս.Բ. Հովսեփյան. Մակերևութային պլազմոն-պոլարիտոնի գերֆոկուսացումը նեղացող զոգավոր ճեղքում	463

CONTENTS

D.L. Hovhannisyan, A.H. Hovhannisyan, G.D. Hovhannisyan, K.A. Hovhannisyan. Numerical modeling of femtosecond optical soliton propagation in a single-mode fiber with allowance for the Raman response imaginary part	391
A. Hakimyfard, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan. Influence of electric field, hydrostatic pressure and temperature on the electronic states in a Pöschl-Teller quantum well	401
R.K. Hovsepyan, N.R. Aghamalyan, S.I. Petrosyan. Field-effect transistor based on ZnO:Li films	407
A.V. Ghazaryan, A.Kh. Manaselyan, A.A. Kirakosyan. Electronic states in the valence band of a cylindrical ZnSe quantum dot	417
V.K. Abrahamyan, N.H. Hakobyan, V.M. Aroutiounian, H.L. Margaryan, D.L. Hovhannisyan. Improvement of turn-on time of liquid crystal phase retarder by using an additional control voltage	429
S.V. Melkonyan, A.V. Surmalyan. Features of the electron's mobility variance in homeopolar semiconductors	440
M.S. Aleksanyan, V.M. Arakelyan, V.M. Aroutiounian, A.Z. Adamyan, G.E. Shahnazaryan. Gas sensor based on nanosize $\text{In}_2\text{O}_3:\text{Ga}_2\text{O}_3$ film	447
Sh.A. Tonoyan. Two-scale generalized model of polypeptide chain in combined solvent	456
S.I. Bozhevolnyi, Kh.V. Nerkararyan, S.B. Hovsepyan. Ultrafocusing of surface plasmon-polariton in a narrowing concave gap	463

СОДЕРЖАНИЕ

Д.Л. Оганесян, А.О. Оганесян, Г.Д. Оганесян, К.А. Оганесян. Численное моделирование процесса распространения фемтосекундного оптического солитона в одномодовом волокне с учетом мнимой части рамановского отклика среды	391
А. Хакимифард, М.Г. Барсегян, К.А. Дюке, А.А. Киракосян. Влияние электрического поля, гидростатического давления и температуры на электронные состояния в квантовой яме Пешля–Теллера.....	401
Р.К. Овсепян, Н.Р. Агамалян, С.И. Петросян. Полевой транзистор на основе пленок ZnO:Li	407
А.В. Казарян, А.Х. Манаселян, А.А. Киракосян. Электронные состояния в валентной зоне цилиндрической квантовой точки ZnSe.....	417
В.К. Абрамян, Н.Г. Акопян, В.М. Арутюнян, А.Л. Маргарян, Д.Л. Оганесян. Улучшение времени включения жидкокристаллического фазового модулятора с помощью дополнительного управляющего напряжения.....	429
С.В. Мелконян, А.В. Сурмалян. Особенности дисперсии подвижности электронов в гомеополярных полупроводниках.....	440
М.С. Алексанян, В.М. Аракелян, В.М. Арутюнян, А.З. Адамян, Г.Э. Шахназарян. Газовый сенсор на основе наноразмерной пленки $\text{In}_2\text{O}_3:\text{Ga}_2\text{O}_3$...	447
Ш.А. Тоноян. Двухмасштабная обобщенная модель полипептидной цепи в комбинированном растворителе.....	456
С.И. Божевольный, Х.В. Неркаряян, С.Б. Овсепян. Сверхфокусировка поверхностного плазмон-поляритона в сужающемся вогнутом зазоре.....	463

Заказ № 280

Тираж 150. Сдано в набор 20.08.2010.

Подписано к печати 25.08.2010. Печ. л. 5.25.

Бумага офсетная. Цена договорная.

Типография НАН РА.

Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24.